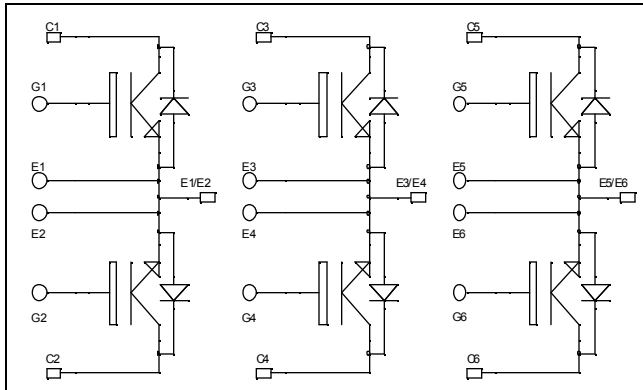


**Triple Dual Common Source  
Trench + Field Stop IGBT®  
Power Module**

**$V_{CES} = 600V$   
 $I_C = 150A @ T_c = 80^\circ C$**

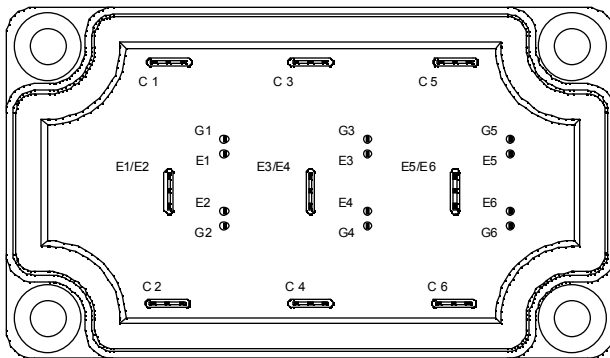


### Application

- AC Switches
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies

### Features

- Trench + Field Stop IGBT® Technology
  - Low voltage drop
  - Low tail current
  - Switching frequency up to 20 kHz
  - Soft recovery parallel diodes
  - Low diode VF
  - Low leakage current
  - Avalanche energy rated
  - RBSOA and SCSOA rated
- Kelvin emitter for easy drive
- Very low stray inductance
  - Symmetrical design
  - Lead frames for power connections
- High level of integration



### Benefits

- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Solderable terminals for easy PCB mounting
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Easy paralleling due to positive TC of VCESat
- Very low (12mm) profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a dual common source configuration of three times the current capability
- RoHS Compliant

### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
$V_{CES}$	Collector - Emitter Breakdown Voltage	600	V
$I_C$	Continuous Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	225
		$T_c = 80^\circ C$	150
$I_{CM}$	Pulsed Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	350
$V_{GE}$	Gate - Emitter Voltage	$\pm 20$	V
$P_D$	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	480
RBSOA	Reverse Bias Safe Operating Area	$T_j = 150^\circ C$	300A @ 550V

**CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

All ratings @  $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified

**Electrical Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_{CES}$	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0\text{V}, V_{CE} = 600\text{V}$			250	$\mu\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	1.5	1.9	V
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	1.7		
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 1.5\text{ mA}$	5.0	5.8	6.5	V
$I_{GES}$	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$			400	nA

**Dynamic Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$C_{ies}$	Input Capacitance	$V_{GE} = 0\text{V}$		9200		pF
$C_{oes}$	Output Capacitance	$V_{CE} = 25\text{V}$		580		
$C_{res}$	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		270		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching ( $25^\circ\text{C}$ )		115		ns
$T_r$	Rise Time	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$		45		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time	$I_C = 150\text{A}$		225		
$T_f$	Fall Time	$R_G = 3.3\Omega$		55		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching ( $150^\circ\text{C}$ )		130		ns
$T_r$	Rise Time	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$		50		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time	$I_C = 150\text{A}$		300		
$T_f$	Fall Time	$R_G = 3.3\Omega$		70		
$E_{on}$	Turn on Energy	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	0.85		mJ
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	1.5		
$E_{off}$	Turn off Energy	$I_C = 150\text{A}$ $R_G = 3.3\Omega$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	4.1		mJ
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	5.3		

**Reverse diode ratings and characteristics**

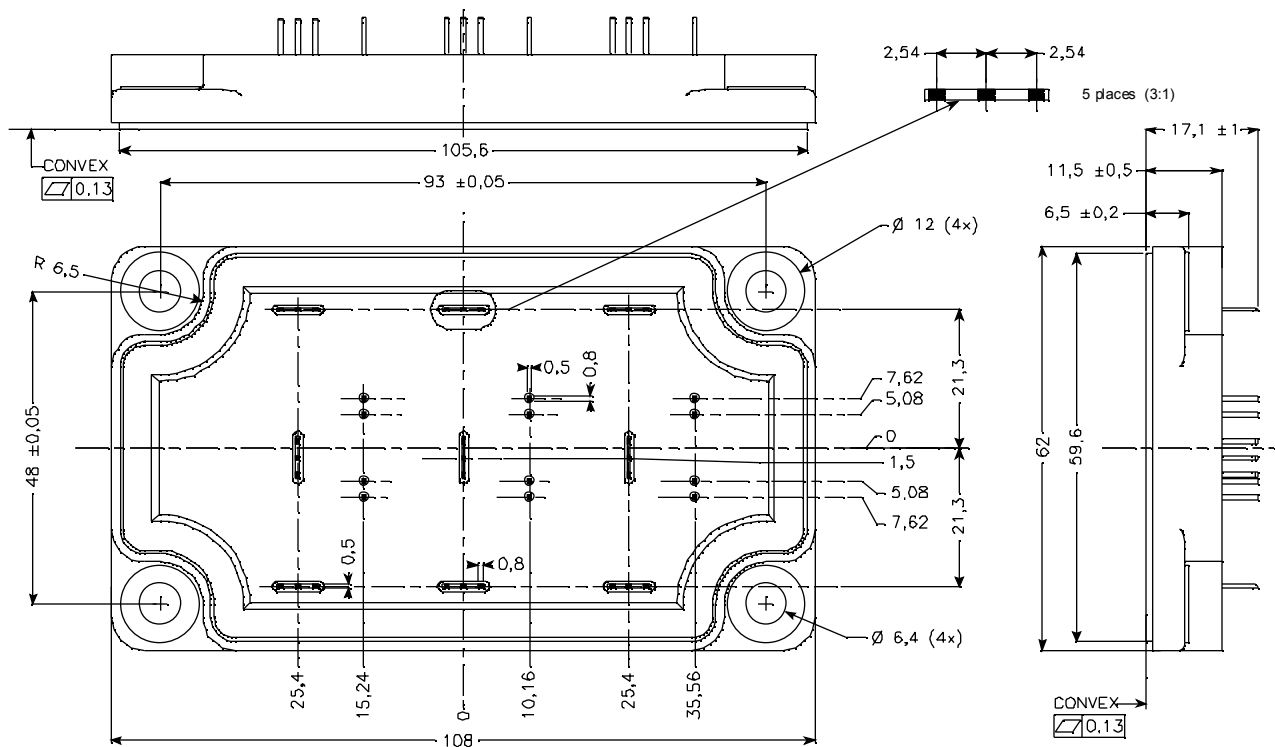
Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		600			V
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	$\mu\text{A}$
			$T_j = 150^\circ\text{C}$		500	
$I_F$	DC Forward Current		$T_c = 80^\circ\text{C}$	150		A
$V_F$	Diode Forward Voltage	$I_F = 150\text{A}$ $V_{GE} = 0\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	1.6	2	V
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	1.5		
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time		$T_j = 25^\circ\text{C}$	130		ns
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	225		
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge	$I_F = 150\text{A}$ $V_R = 300\text{V}$ $di/dt = 3000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	6.9		$\mu\text{C}$
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	14.5		
$E_r$	Reverse Recovery Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$	1.6		mJ
			$T_j = 150^\circ\text{C}$	3.5		

## Thermal and package characteristics

Symbol Characteristic

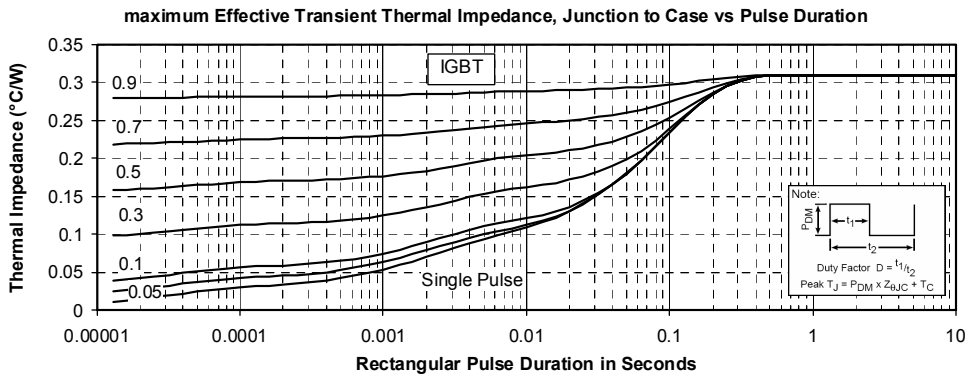
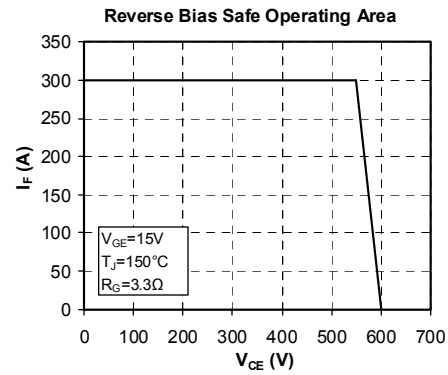
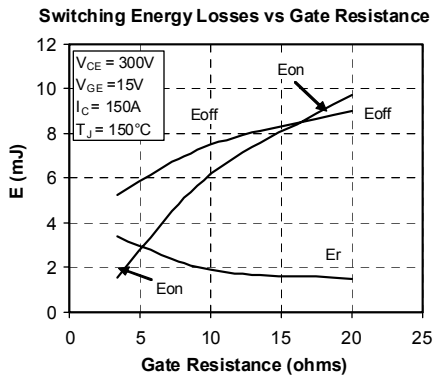
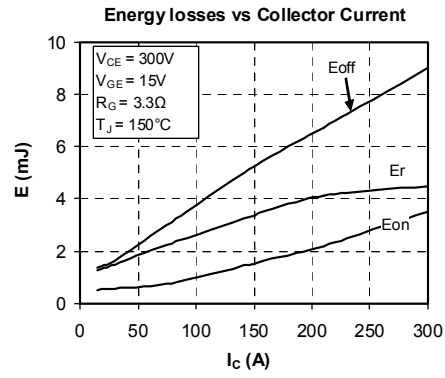
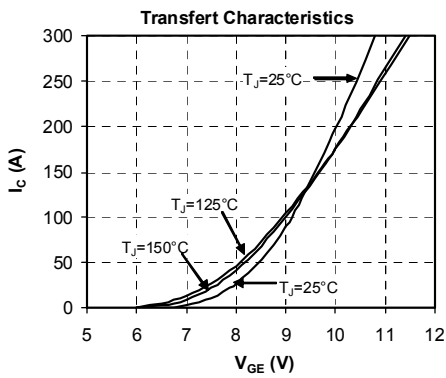
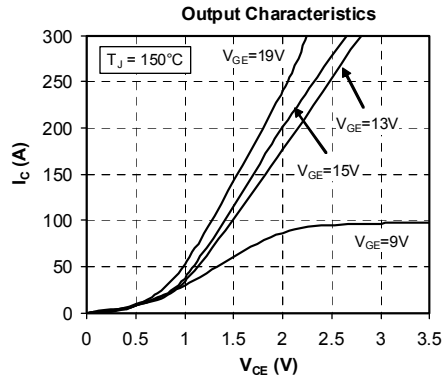
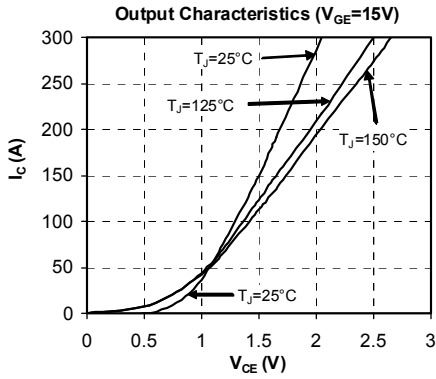
			Min	Typ	Max	Unit
R <sub>thJC</sub>	Junction to Case Thermal Resistance	IGBT			0.31	°C/W
		Diode			0.52	
V <sub>ISOL</sub>	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, I <sub>isol</sub> <1mA, 50/60Hz		2500			V
T <sub>J</sub>	Operating junction temperature range		-40		175	°C
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range		-40		125	
T <sub>C</sub>	Operating Case Temperature		-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	5	N.m
Wt	Package Weight				250	g

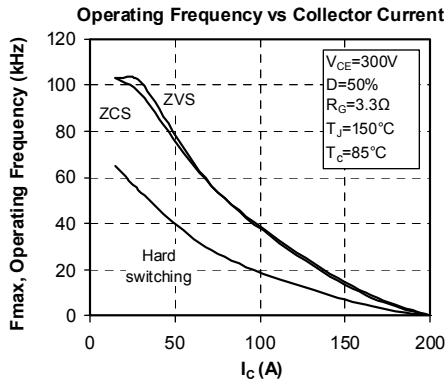
## SP6-P Package outline (dimensions in mm)



See application note 1902 - Mounting Instructions for SP6-P (12mm) Power Modules on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

## Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)